

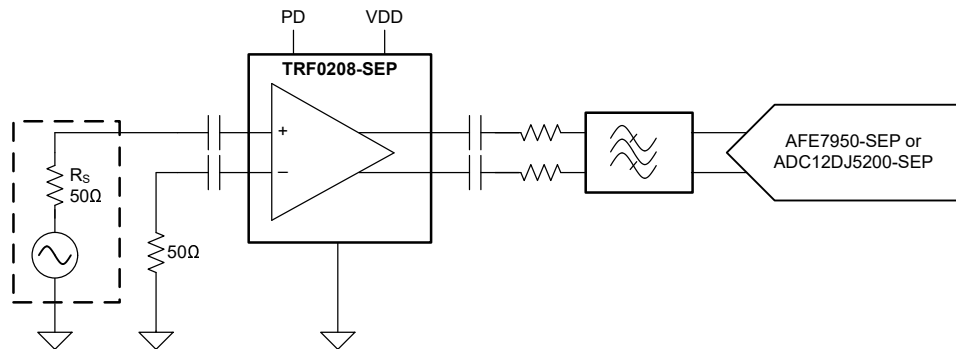
TRF0208-SEP 抗辐射、近直流至 11GHz、全差分射频放大器

1 特性

- 提供供应商项目图，[VID V62/23605](#)
- 辐射：
 - 电离辐射总剂量 (TID)
 - 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 30krad (Si) TID
 - 无增强低剂量率敏感性 (ELDRS) 工艺
 - 高剂量率辐射批次验收测试 (HDR RLAT) 高达 30krad (Si) TID
 - 单粒子效应 (SEE)
 - 单粒子锁定 (SEL) 对于 43MeV-cm²/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
 - 单粒子瞬变 (SET) 的特征值基于 43MeV-cm²/mg 的 LET
- 航天增强型塑料 (SEP)
 - 无铅结构
 - 工作温度范围：-55°C 至 +125°C
- 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
- 在单端转差分模式下具有 16dB 的固定功率增益
- 带宽：11GHz，3dB
- 增益平坦度：8GHz，1dB
- OIP3：36dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
- P1dB：14.5dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
- NF：6.8dB (2GHz)、6.8dB (6GHz)
- 增益和相位不平衡：±0.3dB 和 ±3°
- 关断特性
- 单电源运行：3.3V
- 有效电流：138mA

2 应用

- 射频采样或 GPS ADC 驱动器



驱动高速 ADC 的 TRF0208-SEP

- 航天和国防
- 相控阵雷达
- 通信有效载荷
- 雷达成像有效载荷
- 抗辐射应用

3 说明

TRF0208-SEP 是一款超高性能全差分放大器 (FDA)，专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 [ADC12DJ5200-SEP](#) 等模数转换器 (ADC) 时，交流耦合应用需要进行单端至差分转换，此款器件则是这类应用的理想选择。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化，并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造，并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF0208-SEP 由单轨电源供电，消耗约 138mA 的运行电流。断电功能有助于实现节能。

器件信息

器件型号 ⁽¹⁾	等级	本体尺寸 ⁽²⁾
TRF0208RPVTNSP ⁽³⁾	飞行等级 SEP	2.00mm × 2.00mm
TRF0208RPVT/EM	工程样片 ⁽⁴⁾	质量 = 7.558mg

- 有关更多信息，请参阅 [节 10](#)。
- 本体尺寸 (长 × 宽) 为标称值，不包括引脚。质量为标称值。
- 预发布器件。
- 这些器件仅适用于工程评估。这些样品按照非合规性流程进行加工处理。这些器件不适用于鉴定、量产、辐射测试或飞行用途。这些器件无法在完整 MIL 额定温度范围内或整个使用寿命中保证其性能。



内容

1 特性	1	7.1 应用信息	16
2 应用	1	7.2 典型应用	18
3 说明	1	7.3 电源相关建议	20
4 引脚配置和功能	3	7.4 布局	20
5 规格	4	8 器件和文档支持	21
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.1 器件支持.....	21
5.2 ESD 等级.....	4	8.2 文档支持.....	21
5.3 建议运行条件.....	4	8.3 接收文档更新通知.....	21
5.4 热性能信息.....	4	8.4 支持资源.....	21
5.5 电气特性.....	5	8.5 商标.....	21
5.6 典型特性.....	7	8.6 静电放电警告.....	21
6 详细说明	14	8.7 术语表.....	21
6.1 概述.....	14	9 修订历史记录	21
6.2 功能方框图.....	14	10 机械、封装和可订购信息	21
6.3 特性说明.....	15	10.1 封装选项附录.....	22
6.4 器件功能模式.....	15	10.2 机械数据.....	23
7 应用和实施	16		

4 引脚配置和功能

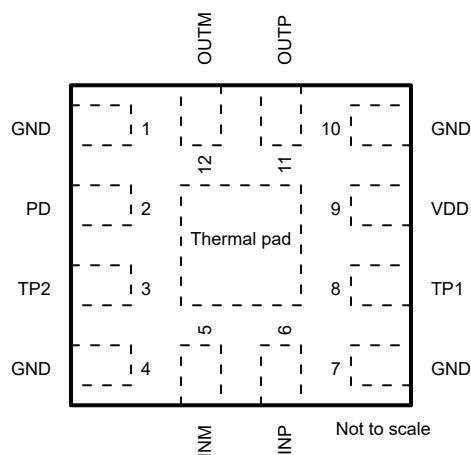


图 4-1. RPV 封装，
12 引脚 WQFN-FCRLF
(顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
GND	1、4、7、10	GND	接地
INM	5	I	差分信号输入，负
INP	6	I	差分信号输入，正
OUTM	12	O	差分信号输出，负
OUTP	11	O	差分信号输出，正
PD	2	I	断电信号。支持 1.8V 和 3.3V 逻辑。 0 = 启用芯片 1 = 断电
TP1	8	—	测试引脚。接地短路。
TP2	3	—	测试引脚。接地短路。
VDD	9	P	3.3V 电源
散热焊盘	Pad	—	散热焊盘。连接到电路板上的接地端。

(1) I = 输入，O = 输出，P = 电源，GND = 地

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压	-0.3	3.7	V
INP、INM	输入引脚电源		20	dBm
V _{PD}	断电引脚电压	-0.3	3.7	V
T _J	结温		150	°C
T _{stg}	贮存温度	-65	150	°C
连续功耗		请参阅热性能信息		

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

5.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准，所有引脚 ⁽¹⁾	±1000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准，所有引脚 ⁽²⁾	±250	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压	3.2	3.3	3.45	V
T _A	环境空气温度	-55	25		°C
T _J	结温			125	°C

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TRF0208-SEP	单位
		RPV (WQFN-FCRLF)	
		12 引脚	
R _{θJA}	结至环境热阻	66.9	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳（顶部）热阻	64.3	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	17.4	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	1.7	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	17.2	°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳（底部）热阻	9.0	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用报告。

5.5 电气特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
交流性能						
SSBW	小信号 3dB 带宽	$V_O = 0.1V_{PP}$		11		GHz
LSBW	大信号 3dB 带宽	$V_O = 1V_{PP}$		11		GHz
1dB 的信噪比 (BW)	1dB 平坦带宽			8		GHz
S21	功率增益	$f = 2\text{GHz}$		16		dB
S11	输入回波损耗	$f = 10\text{MHz}$ 至 8GHz		-10		dB
S12	反向隔离	$f = 2\text{GHz}$		-35		dB
Imb_{GAIN}	增益不平衡	$f = 10\text{MHz}$ 至 8GHz		± 0.3		dB
$\text{Imb}_{\text{PHASE}}$	相位不平衡	$f = 10\text{MHz}$ 至 8GHz		± 3		度
CMRR	共模抑制比 ⁽¹⁾	$f = 2\text{GHz}$		-45		dB
HD2	二阶谐波失真	$f = 0.5\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-70		dBc
		$f = 2\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-65		
		$f = 6\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-52		
		$f = 8\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-50		
HD3	三阶谐波失真	$f = 0.5\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-68		dBc
		$f = 2\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-63		
		$f = 6\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-54		
		$f = 8\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-60		
IMD2	二阶互调失真	$f = 0.5\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}/\text{子载波}$ (10MHz 间隔)		-72		dBc
		$f = 2\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}/\text{子载波}$ (10MHz 间隔)		-64		
		$f = 6\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}/\text{子载波}$ (10MHz 间隔)		-54		
		$f = 8\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}/\text{子载波}$ (10MHz 间隔)		-48		
IMD3	三阶互调失真	$f = 0.5\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}/\text{子载波}$ (10MHz 间隔)		-77		dBc
		$f = 2\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}/\text{子载波}$ (10MHz 间隔)		-80		
		$f = 6\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}/\text{子载波}$ (10MHz 间隔)		-70		
		$f = 8\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}/\text{子载波}$ (10MHz 间隔)		-48		
OP1dB	输出 1dB 压缩点	$f = 0.5\text{GHz}$		11		dBm
		$f = 2\text{GHz}$		14.5		
		$f = 6\text{GHz}$		11		
		$f = 8\text{GHz}$		7.5		

5.5 电气特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
OIP2	输出二阶截点	f = 0.5GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		68		dBm
		f = 2GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		60		
		f = 6GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		50		
		f = 8GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		45		
OIP3	输出三阶截取点	f = 0.5GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		34		dBm
		f = 2GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		36		
		f = 4GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		35		
		f = 6GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		32		
		f = 8GHz，P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		21		
NF	噪声系数	f = 0.5GHz		6.5		dB
		f = 2GHz		6.8		
		f = 6GHz		6.8		
		f = 8GHz		8.5		
阻抗						
Z _{O-DIFF}	差分输出阻抗	f = 直流 (器件内部)		3		Ω
Z _{IN}	单端输入阻抗	使用 50 Ω 电阻端接 INM 引脚		50		Ω
瞬态						
V _{OMAX}	最大输出电压 (差分)			2		V _{PP}
V _{OSAT}	输出饱和电压电平 (差分)	f = 2GHz		3.9		V _{PP}
t _{REC}	过驱动恢复时间	使用持续时间为 2ns 的 - 0.5V _P 输入脉冲		0.2		ns
电源						
I _{QA}	有效电流	V _{DD} 引脚上的电流，PD = 0		138		mA
I _{QPD}	关断静态电流	V _{DD} 引脚上的电流，PD = 1		7		mA
使能						
V _{PDHIGH}	PD 引脚逻辑高电平		1.45			V
V _{PDLLOW}	PD 引脚逻辑低电平			0.8		V
I _{PDBIAS}	PD 偏置电流 (PD 引脚上的电流)	PD = 高电平 (1.8V 逻辑)		50	100	μA
		PD = 高电平 (3.3V 逻辑)		200	250	
C _{PD}	PD 引脚电容			2		pF
t _{ON}	导通时间	50% V _{PD} 至 90% 射频		200		ns
t _{OFF}	关断时间	50% V _{PD} 至 10% 射频		50		ns

(1) 使用公式 $(S21 - S31) / (S21 + S31)$ 计算得出。端口 1 : INP, 端口 2 : OUTP, 端口 3 : OUTM。

5.6 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ，温度曲线指定环境温度， $V_{DD} = 3.3\text{V}$ ， $50\ \Omega$ 单端输入， $100\ \Omega$ 差分输出（除非另有说明）

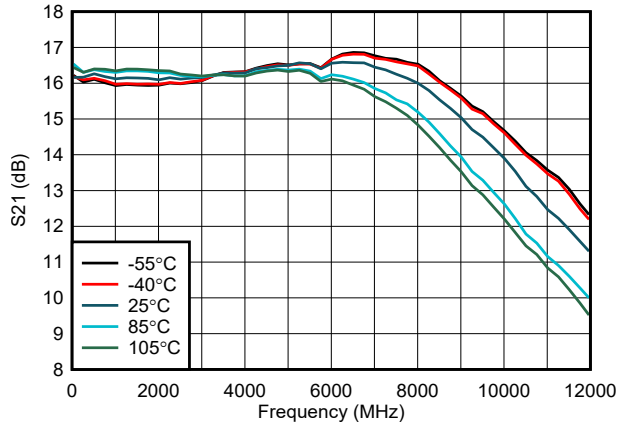


图 5-1. 整个温度范围内的功率增益

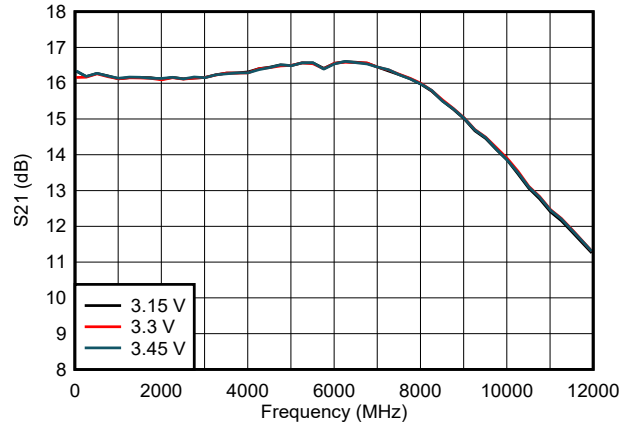


图 5-2. 整个 V_{DD} 范围内的功率增益

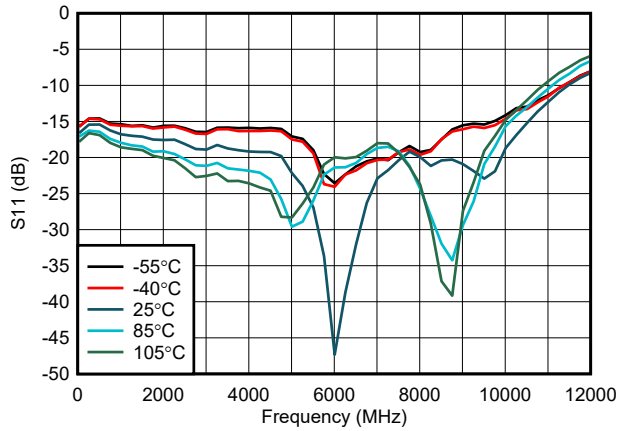


图 5-3. 整个温度范围内的回波损耗

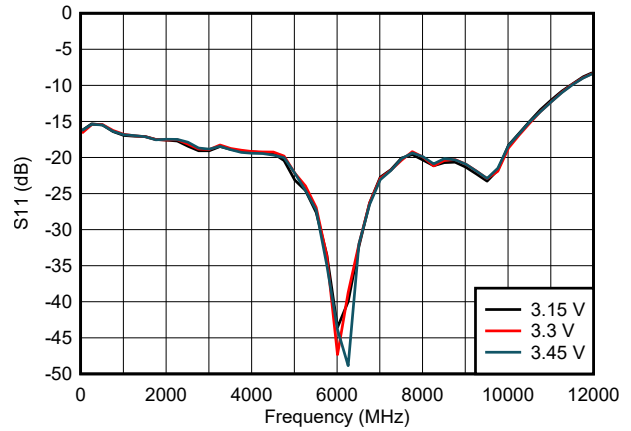


图 5-4. 整个 V_{DD} 范围内的回波损耗

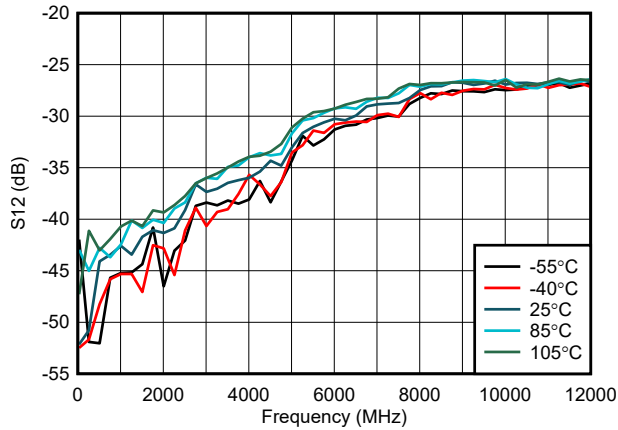


图 5-5. 整个温度范围内的反向隔离

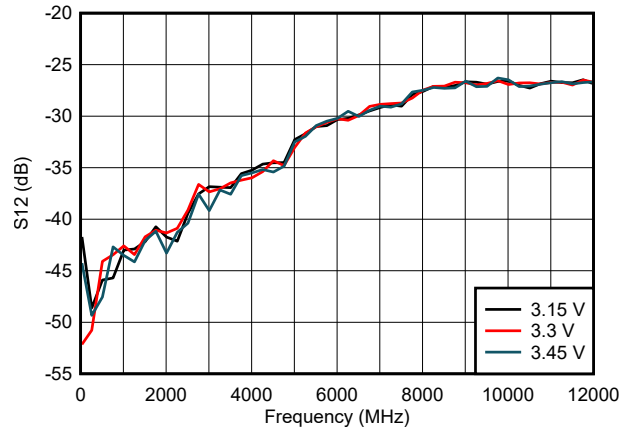
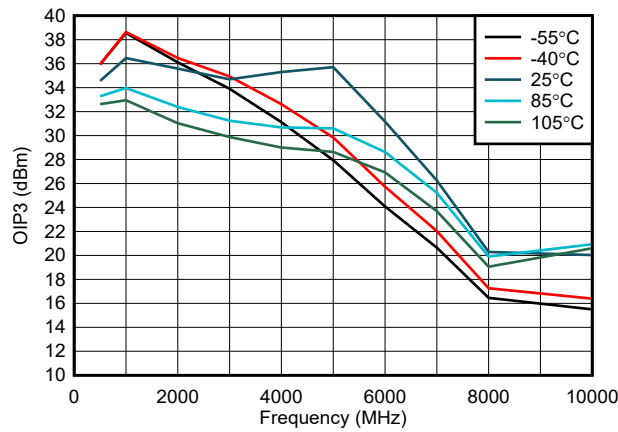


图 5-6. 整个 V_{DD} 范围内的反向隔离

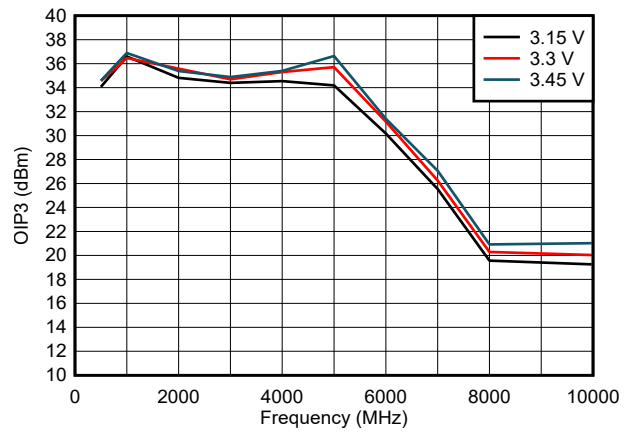
5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, 温度曲线指定环境温度, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)



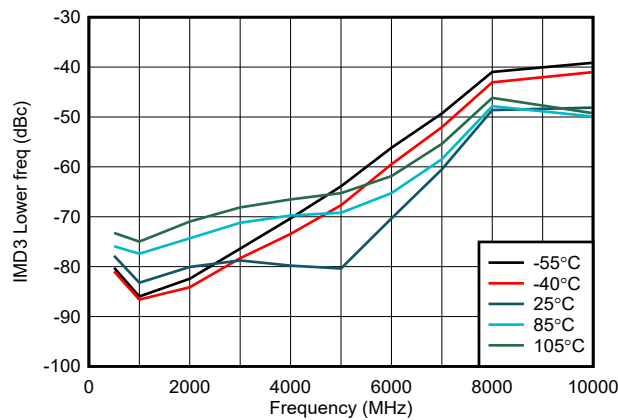
P_O /子载波 = -4dBm, 10MHz 子载波间隔

图 5-7. 整个温度范围内的 OIP3



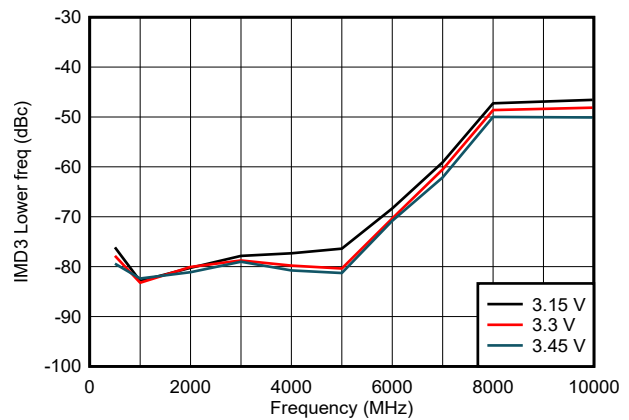
P_O /子载波 = -4dBm, 10MHz 子载波间隔

图 5-8. 整个 V_{DD} 范围内的 OIP3



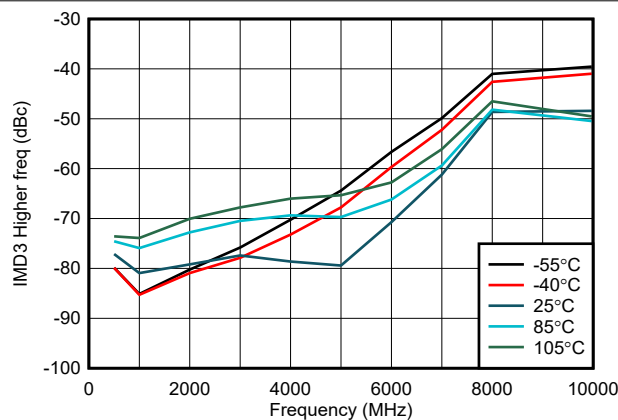
在 $(2f_1-f_2)$ 频率条件下, $f_1 < f_2$; P_O /子载波 = -4dBm, 10MHz 子载波间隔

图 5-9. 整个温度范围内的 IMD3 更低



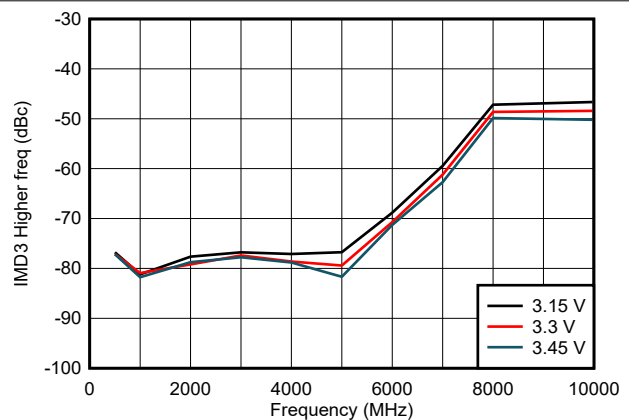
在 $(2f_1-f_2)$ 频率条件下, $f_1 < f_2$; P_O /子载波 = -4dBm, 10MHz 子载波间隔

图 5-10. 整个 V_{DD} 范围内的 IMD3 更低



在 $(2f_2-f_1)$ 频率条件下, $f_1 < f_2$; P_O /子载波 = -4dBm, 10MHz 子载波间隔

图 5-11. 整个温度范围内的 IMD3 更高

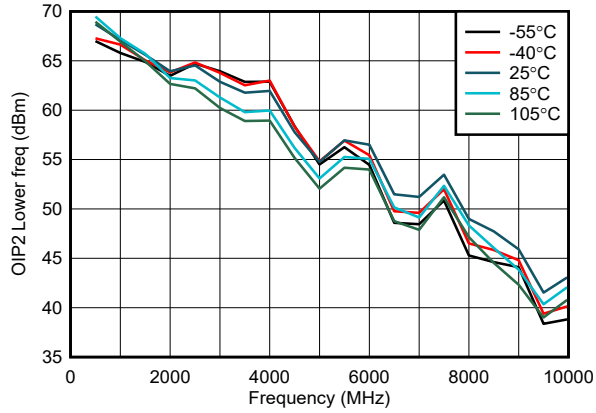


在 $(2f_2-f_1)$ 频率条件下, $f_1 < f_2$; P_O /子载波 = -4dBm, 10MHz 子载波间隔

图 5-12. 整个 V_{DD} 范围内的 IMD3 更高

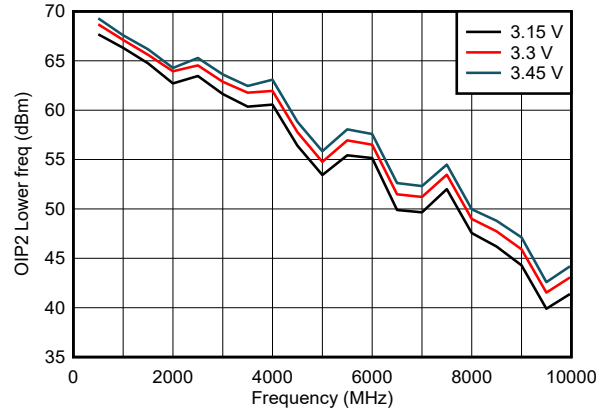
5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, 温度曲线指定环境温度, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)



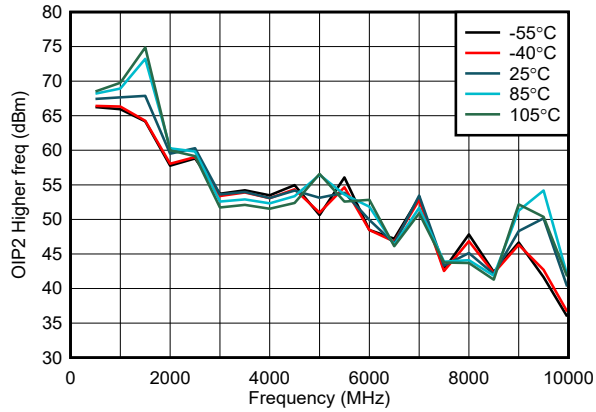
在 $(f_2 - f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-13. 整个温度范围内的 OIP2 更低



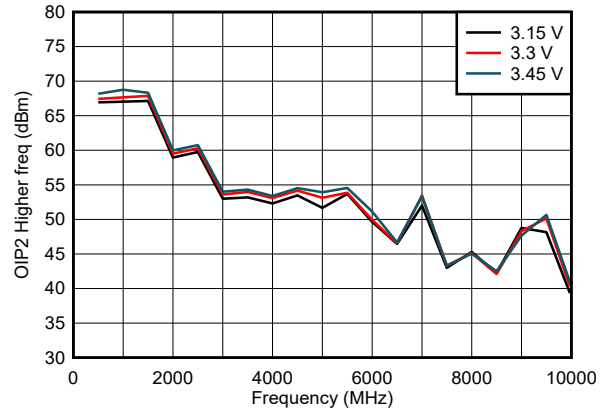
在 $(f_2 - f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-14. 整个 V_{DD} 范围内的 OIP2 更低



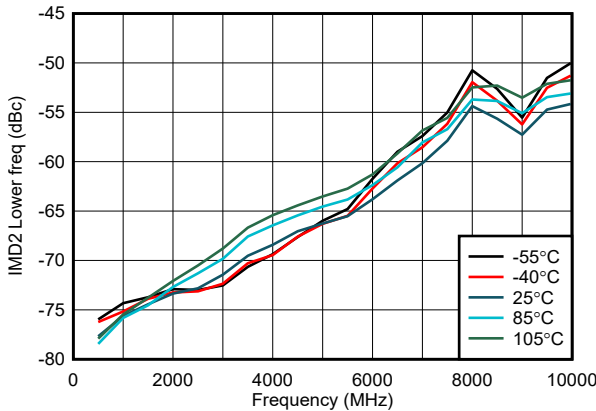
在 $(f_2 + f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-15. 整个温度范围内的 OIP2 更高



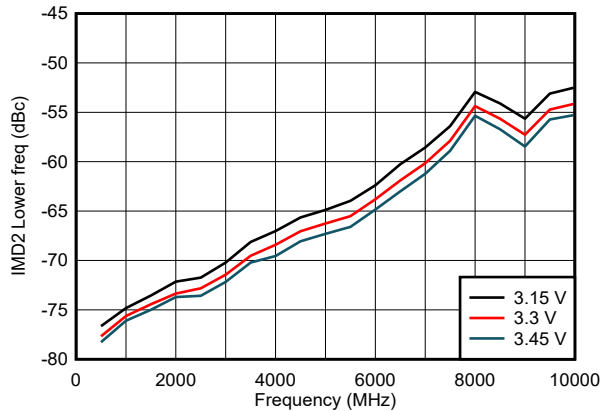
在 $(f_2 + f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-16. 整个 V_{DD} 范围内的 OIP2 更高



在 $(f_2 - f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-17. 整个温度范围内的 IMD2 更低

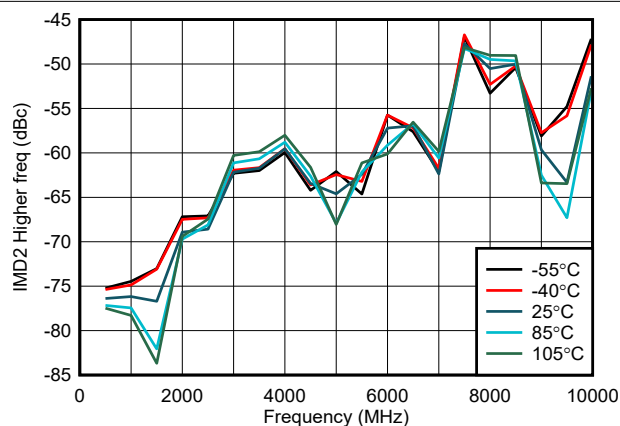


在 $(f_2 - f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-18. 整个 V_{DD} 范围内的 IMD2 更低

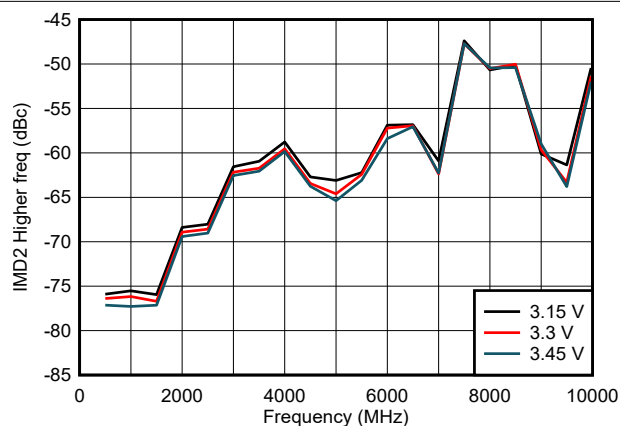
5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, 温度曲线指定环境温度, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)



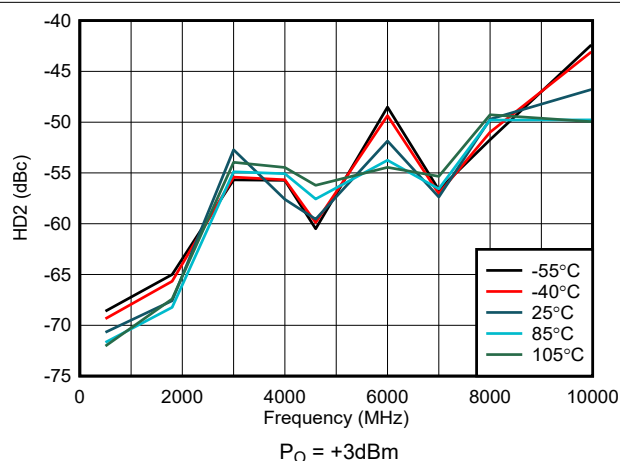
在 (f_2+f_1) 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-19. 整个温度范围内的 IMD2 更高



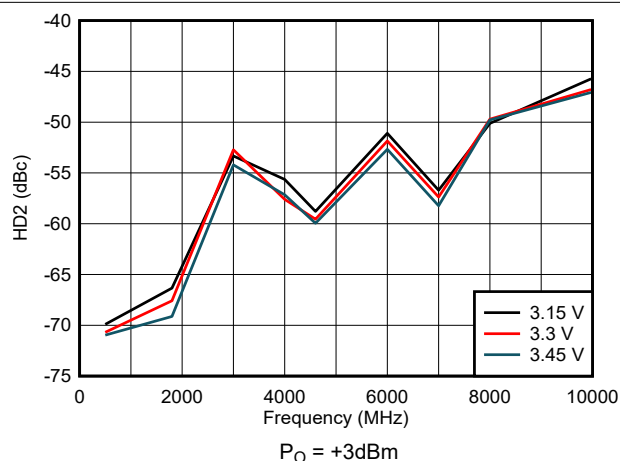
在 (f_2+f_1) 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-20. 整个 V_{DD} 范围内的 IMD2 更高



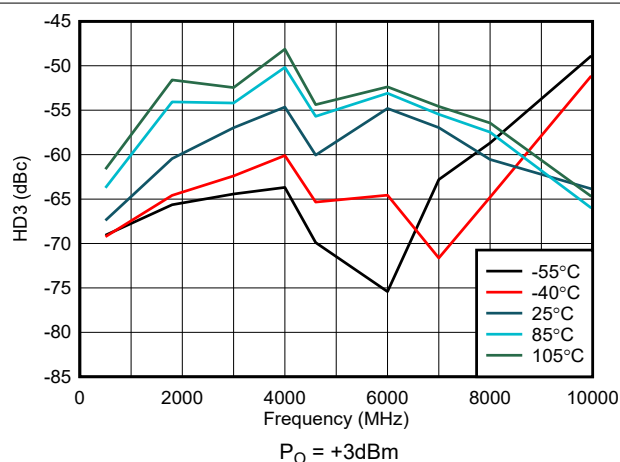
$P_O = +3\text{dBm}$

图 5-21. 整个温度范围内的 HD2



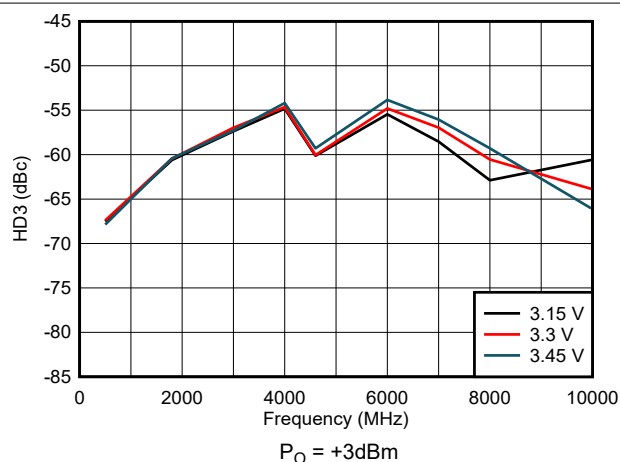
$P_O = +3\text{dBm}$

图 5-22. 整个 V_{DD} 范围内的 HD2



$P_O = +3\text{dBm}$

图 5-23. 整个温度范围内的 HD3



$P_O = +3\text{dBm}$

图 5-24. 整个 V_{DD} 范围内的 HD3

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, 温度曲线指定环境温度, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

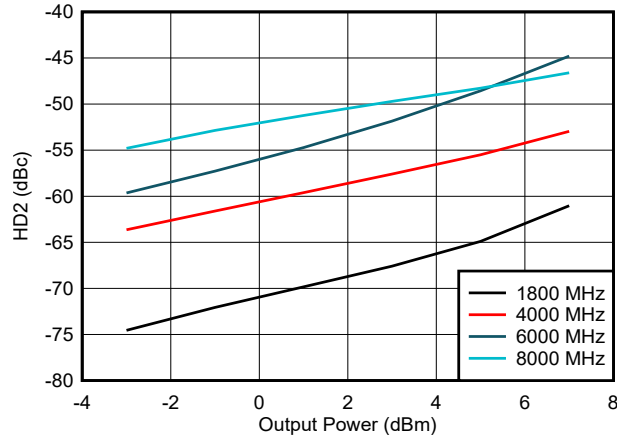


图 5-25. HD2 与输出功率间的关系

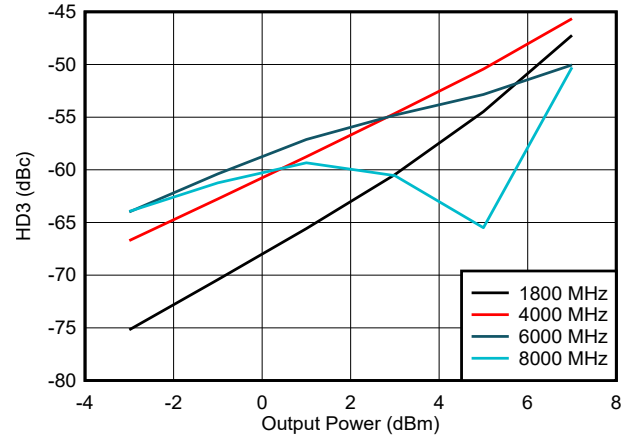


图 5-26. HD3 与输出功率间的关系

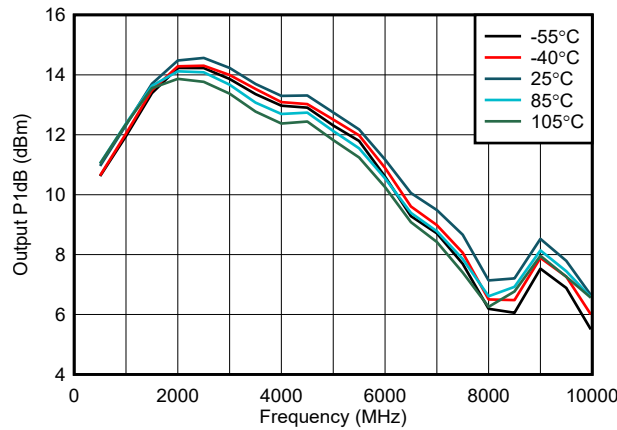


图 5-27. 整个温度范围内的输出 P1dB

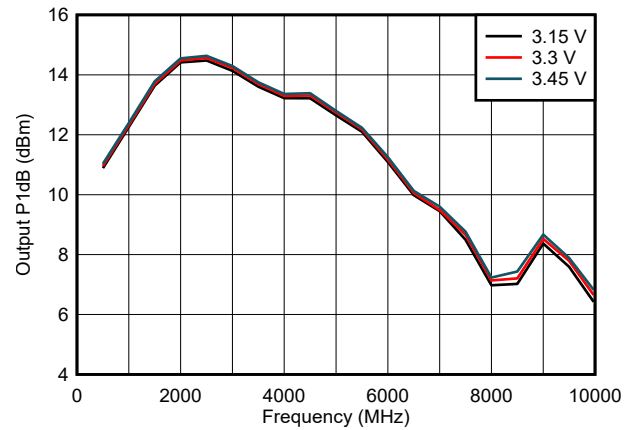


图 5-28. 整个 V_{DD} 范围内的输出 P1dB

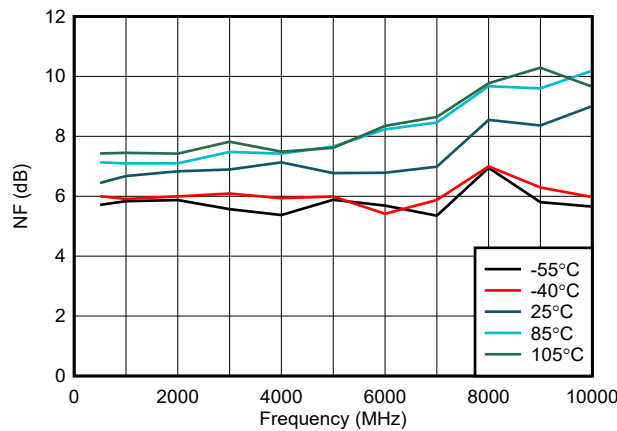


图 5-29. 整个温度范围内的 NF

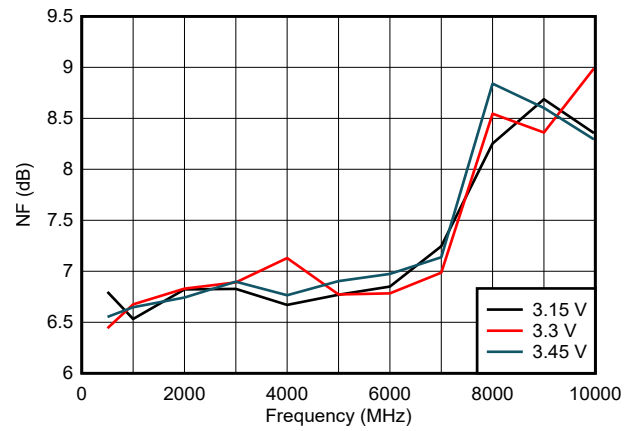


图 5-30. 整个 V_{DD} 范围内的 NF

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, 温度曲线指定环境温度, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

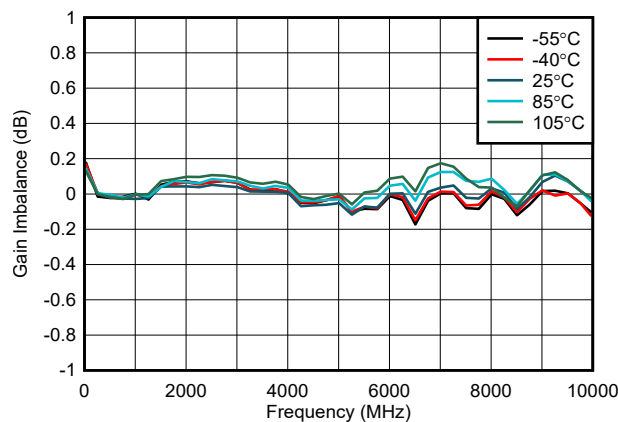


图 5-31. 增益不平衡

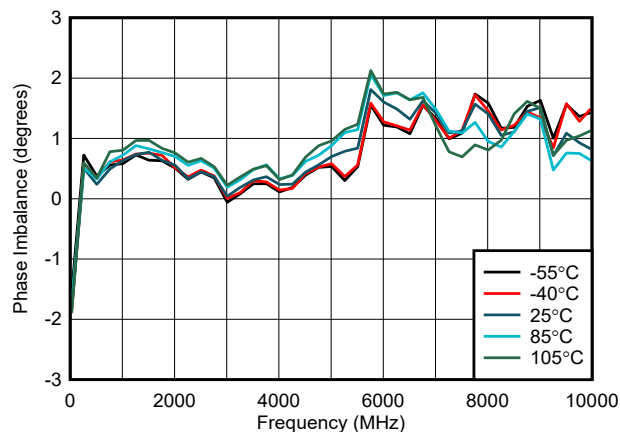


图 5-32. 相位不平衡

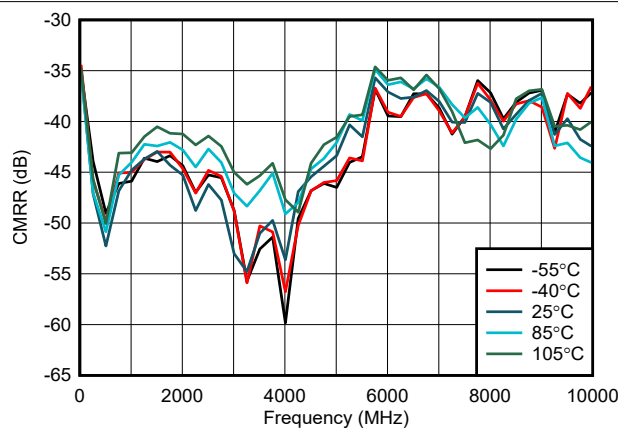
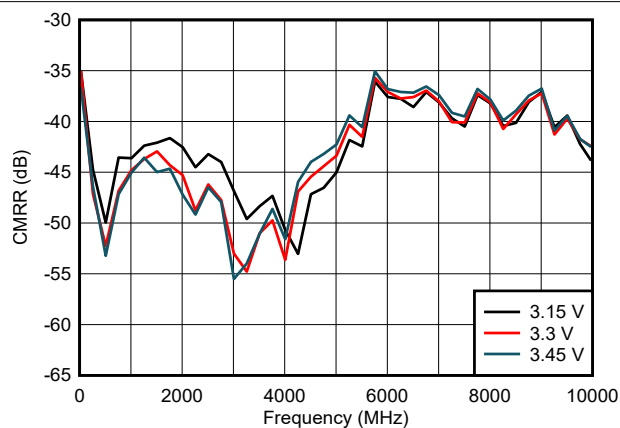
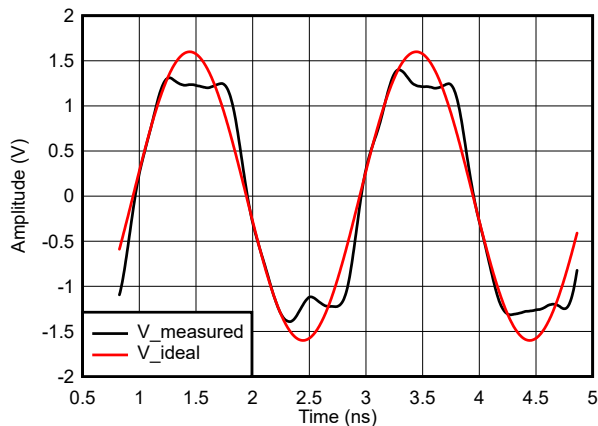
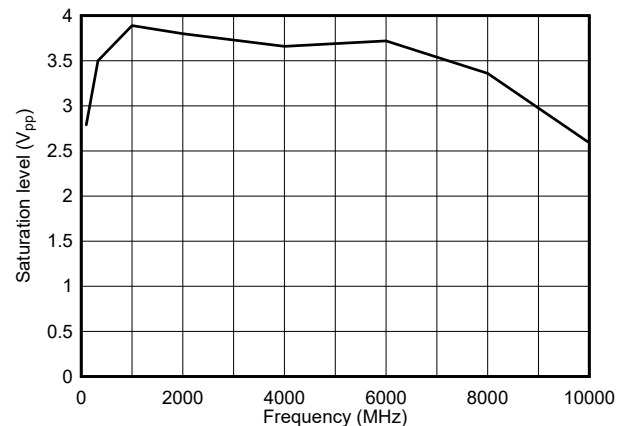


图 5-33. 整个温度范围内的 CMRR

图 5-34. 整个 V_{DD} 范围内的 CMRR

输入 = -2 dBm, $f = 500\text{MHz}$

图 5-35. 过驱恢复

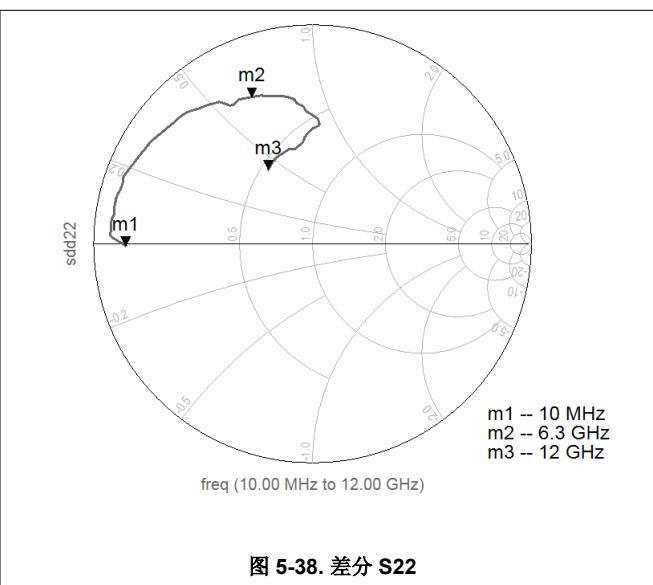
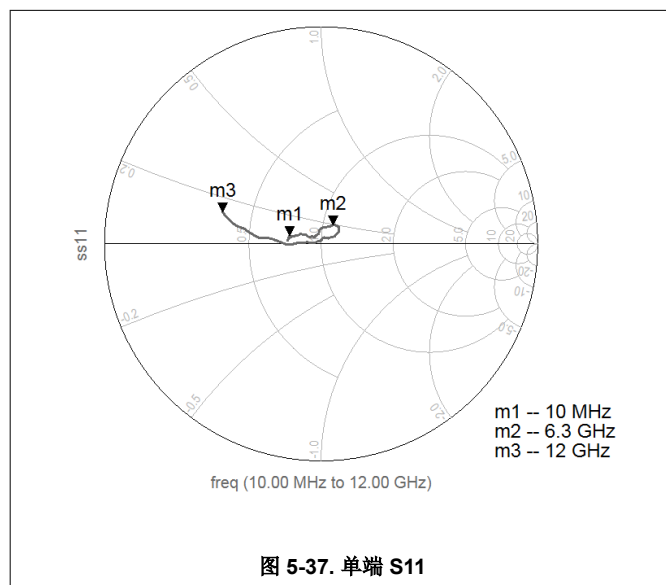


输入 = +6 dBm

图 5-36. 饱和电压 (差分)

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ，温度曲线指定环境温度， $V_{DD} = 3.3\text{V}$ ， $50\ \Omega$ 单端输入， $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)



6 详细说明

6.1 概述

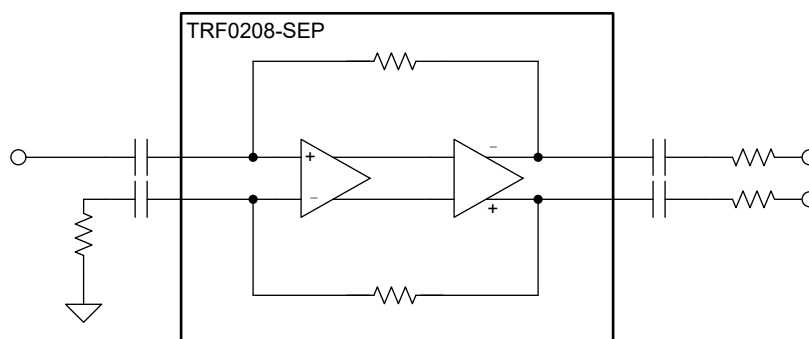
TRF0208-SEP 是一款超高性能放大器，针对射频 (RF) 和中频 (IF) 进行了优化，信号带宽高达 11GHz。该器件适用于在驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端转差分转换的交流耦合应用。低频响应仅受到 PCB 上的交流耦合电容器的限制。如果最低信号频率为 10MHz，应使用 100nF 交流耦合电容器。如果最低信号频率为 9kHz，应在每个输入/输出引脚上使用一个与 100nF 电容器并联的 4.7μF 电容器。该器件采用两级架构，在单端转差分模式下，对于从 100Ω 源驱动的单端输入，当驱动 50Ω 差分负载时，可提供大约 16dB 的增益。该器件还可用作全差分放大器。

该器件在 PCB 上不需要任何上拉或下拉元件，因此可简化布局并在整个带宽范围内提供超高的性能。

输入和输出采用交流耦合。TRF0208-SEP 由 3.3V 电源供电，还提供了断电功能。

6.2 功能方框图

下图显示了 TRF0208-SEP 的功能方框图。该器件基本上包含两个采用电压反馈配置的级。



6.3 特性说明

6.3.1 全差分放大器

TRF0208-SEP 是一种电压反馈全差分放大器 (FDA)，按架构具有固定增益。通过使用 $50\ \Omega$ 电阻端接 INM 引脚并直接驱动 INP 引脚（无任何外部元件），TRF0208-SEP 将作为单端转差分放大器发挥最佳效用。

该放大器具有非线性消除电路，可在宽频率范围内提供出色的线性性能。

该放大器的输出为低直流阻抗。因此，如果需要，可以通过添加适当的串联电阻或衰减器垫来使放大器的输出与负载匹配。

6.3.2 单电源供电

TRF0208-SEP 由 3.3V 单电源供电。输入和输出偏置电压在内部设定。因此，在全部四个射频输入和输出引脚上对电路板上的信号路径进行交流耦合。单电源供电可简化电路板设计。

6.4 器件功能模式

TRF0208-SEP 具有两种功能模式：工作模式和断电模式。功能模式由 PD 引脚控制，如下所述。

6.4.1 断电模式

该器件具有断电选项。PD 引脚用于对放大器进行断电。此引脚支持 1.8V 和 3.3V 数字逻辑，并以地为基准。逻辑 1 会关闭器件并将器件置于低静态电流状态。

禁用后，信号路径仍然通过内部电路存在。与任何禁用的反馈放大器一样，施加到被禁用器件的输入信号仍通过此路径以较低电平显示在输出端。

7 应用和实例

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

7.1 应用信息

7.1.1 驱动高速 ADC

TRF0208-SEP 的一个常见应用是驱动具有差分输入的高速 ADC（例如 ADC12DJ5200-SEP 或 AFE7950-SEP）。由于难以获得高带宽线性放大器，无源平衡-非平衡变压器通常用于驱动具有每秒千兆样本 (GSPS) 采样率的 ADC。TRF0208-SEP 通常配置为单端转差分 (S2D) 射频放大器，具有出色的带宽平坦度、增益和相位不平衡，可媲美甚至超过昂贵的无源射频平衡-非平衡变压器。

图 7-1 显示了 ADC12DJ5200-SEP 的典型接口电路。根据 ADC 和系统要求，该电路可以简化，也可以更复杂。

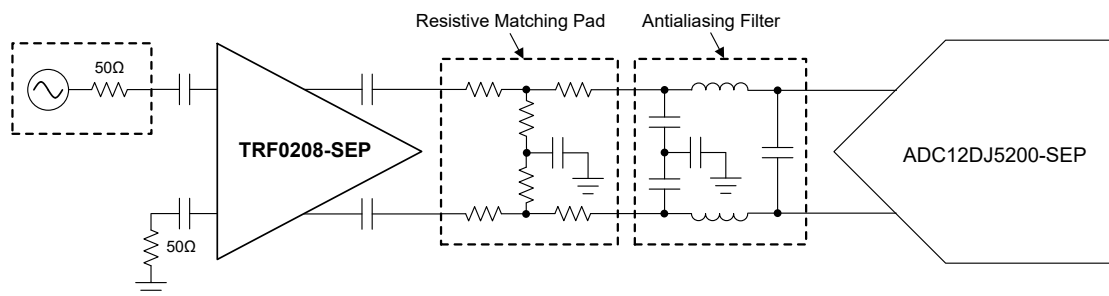
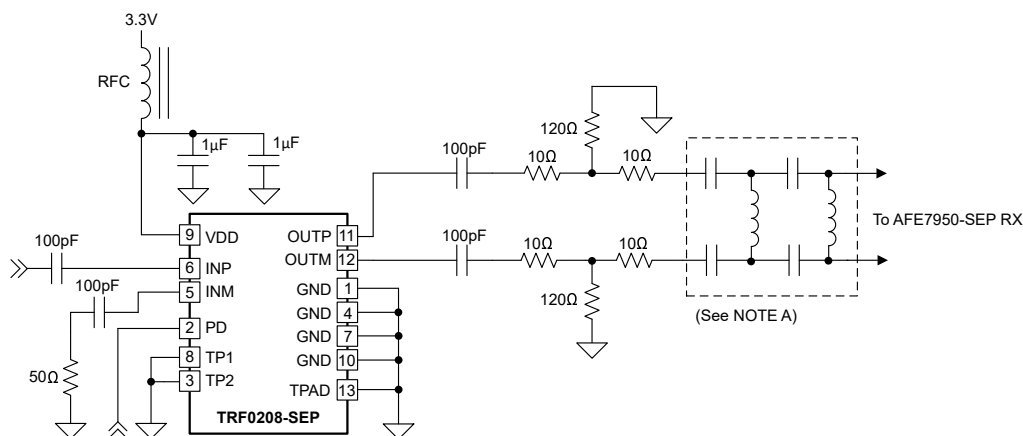


图 7-1. 与 ADC12DJ5200-SEP 连接

图 7-1 显示了驱动器放大器和 ADC 之间电路的两个部分：即匹配垫（或衰减器垫）和抗混叠滤波器。对于这些电路，应使用小尺寸的射频质量无源器件。TRF0208-SEP 的输出摆幅根据设计可以满足量程驱动这些 ADC，同时不会使 ADC 过驱。借助该功能，无需在 ADC 上使用任何限压器件。

图 7-2 显示了 AFE7950-SEP 的典型接口电路，其中 TRF0208-SEP 是 S2D 放大器。



A. AFE 匹配网络 - 元件类型 (L 或 C) 和值取决于通道 (A、B、C、D、FB1 和 FB2) 和频带。

图 7-2. 与 AFE7950-SEP 连接

7.1.2 计算输出电压摆幅

本节提供了不同输入功率级别下的输出电压摆幅的快速参考。在本例中，输出端端接一个 $100\ \Omega$ 差分负载，并假定功率增益为 16dB 。

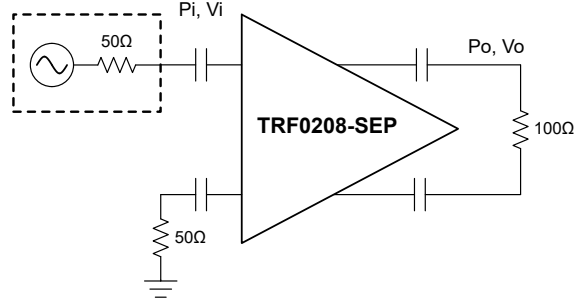


图 7-3. 功率和电压电平

$$\text{Voltage gain} = 20 \times \log(V_O / V_I) \quad (1)$$

$$\text{Power gain} = 10 \times \log(P_O / P_I) = 10 \times \log((V_O^2 / 100) / (V_I^2 / 50)) = 20 \times \log(V_O / V_I) - 3\text{dB} \quad (2)$$

表 7-1. 不同输入功率级别下的输出电压摆幅

输入		输出 (TRF0208-SEP)	
P_I (dBm ₅₀)	V_I (V _{PP})	P_O (dBm ₁₀₀)	V_O (V _{PP})
-20	0.063	-4	0.564
-15	0.112	1	1.004
-10	0.2	6	1.785
-9	0.224	7	2.002

7.1.3 散热注意事项

TRF0208-SEP 采用 $2\text{mm} \times 2\text{mm}$ WQFN-FCRLF 封装，因此具有出色的热属性。将芯片下方的散热焊盘连接到接地平面。如果可能，将接地平面在四个角处短接到芯片的其他接地引脚，以使热量传播到 PCB 顶层。使用一个散热过孔将 PCB 顶层的散热焊盘平面连接到内层接地平面，以允许热量传播到内层。

7.2 典型应用

本节将介绍 TRF0208-SEP 用作 AFE7950-SEP 的 S2D 放大器的示例。

7.2.1 TRF0208-SEP 在接收链中

本节介绍了一个射频接收器链，其中 TRF0208-SEP 用作单端转差分 (S2D) 放大器并驱动 AFE7950-SEP 的接收通道。

图 7-4 显示了由 TRF0208-SEP 驱动 AFE7950-SEP 接收通道的设计的通用原理图。元件的确切值取决于匹配 AFE7950-SEP 前端的频带。

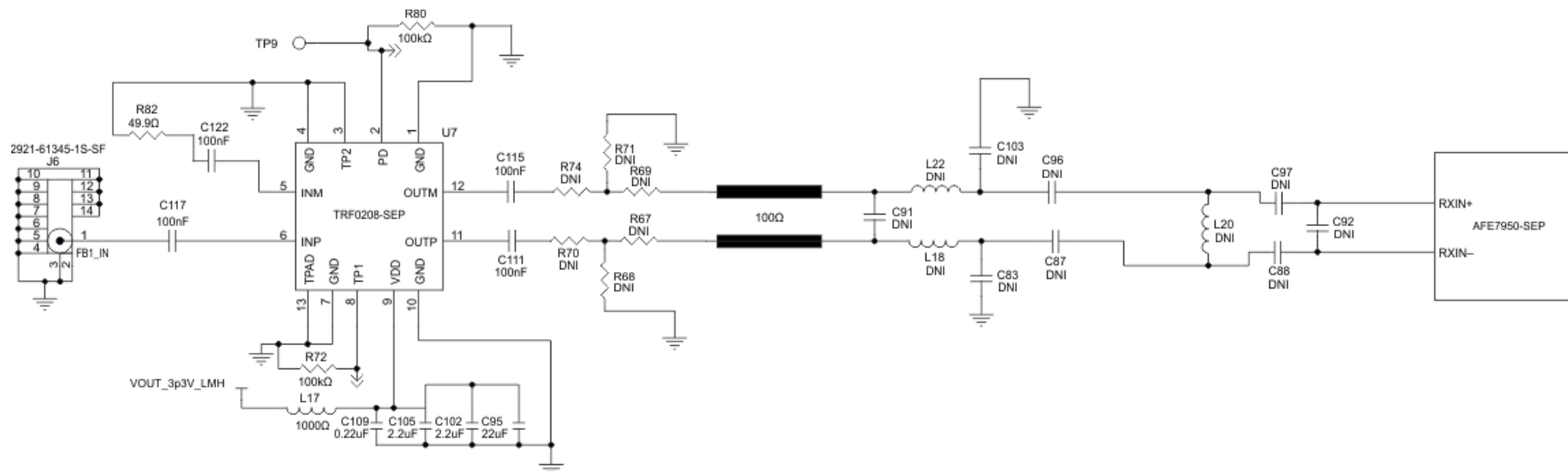


图 7-4. TRF0208-SEP 在采用 AFE7950-SEP 的接收链中

7.2.1.1 设计要求

AFE7950-SEP 通道需要匹配到 8.2GHz。

7.2.1.2 详细设计过程

TRF0208-SEP 配置为 S2D 放大器。靠近 TRF0208-SEP 输出端的部分是用于实现可靠匹配的衰减器垫。靠近 AFE7950-SEP 的部分是依赖于通道的 AFE7950-SEP ADC 输入的匹配网络。匹配元件的选择基于 AFE7950-SEP 回波损耗数据和一些最终优化，因为制造的电路板参数会影响所需的确切元件值。

对于与 8.2GHz 中心频率匹配的通道，表 7-2 显示了相关设计的物料清单 (BOM) 值。

表 7-2. 中心频率 = 8.2GHz 时 RX 链的元件值

部分	指示符	类型	值	安装或请勿安装
直流阻断电容器	C117	电容器	100nF	安装
直流阻断电容器	C115	电容器	100nF	安装
直流阻断电容器	C111	电容器	100nF	安装
直流阻断电容器	C122	电容器	100nF	安装
衰减器	R74	电阻器	10Ω	安装
衰减器	R70	电阻器	10Ω	安装
衰减器	R69	电阻器	10Ω	安装
衰减器	R67	电阻器	10Ω	安装
衰减器	R71	电阻器	140Ω	安装
衰减器	R68	电阻器	140Ω	安装
INM 端子	R82	电阻器	50Ω	安装
匹配	C91	—	—	请勿安装
匹配	L20	—	—	请勿安装
匹配	C103	—	—	请勿安装
匹配	C83	—	—	请勿安装
匹配	L22	电感器	0.1nH	安装
匹配	L18	电感器	0.1nH	安装
匹配	C96	电感器	0.1nH	安装
匹配	C87	电感器	0.1nH	安装
匹配	C97	电容器	0.8pF	安装
匹配	C88	电容器	0.8pF	安装
匹配	C92	电感器	0.3nH	安装

7.3 电源相关建议

TRF0208-SEP 需要 3.3V 单电源供电。电源去耦对于高频性能至关重要。通常使用两个或三个电容器来进行电源去耦。对于容值最小的电容器，请在最靠近器件 V_{DD} 引脚的位置使用一个小型电容器元件。将具有较大容值和较大尺寸的大容量去耦电容器放置在小型电容器旁边。另请参阅节 7.4。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

TRF0208-SEP 是一款具有大约 16dB 增益的宽带电压反馈放大器。使用具有相对高增益的宽带射频放大器进行设计时，请务必采取一定的电路板布局布线预防措施，以保持稳定性和优化的性能。使用多层电路板来保持信号完整性、电源完整性和热性能。图 7-5 展示了一个良好布局的示例。此图仅显示了顶层。

将射频输入和输出线路布线为接地共面波导 (GCPW) 线路。对于第二层，可使用连续的接地层，不要在放大器区域附近有任何接地切口。为了更大限度地减少相位不平衡，应匹配输出差分线路的长度。尽可能使用小尺寸无源器件。此外，还应注意输入侧布局。使用 50Ω 线路进行 INP 布线，并通过将交流耦合电容器和 50Ω 电阻放置在非常靠近器件的位置，确保 INM 引脚上的端接具有低寄生效应。使用具有射频质量的 50Ω 电阻进行端接。确保顶层和内层的接地平面与过孔缝合良好。

在器件下方放置散热过孔，用于将顶部散热焊盘与 PCB 内层中的接地平面连接在一起。为了改善散热，请通过接地引脚将散热焊盘连接到顶层接地平面（请参阅下一节中的布局示例）。

7.4.2 布局示例

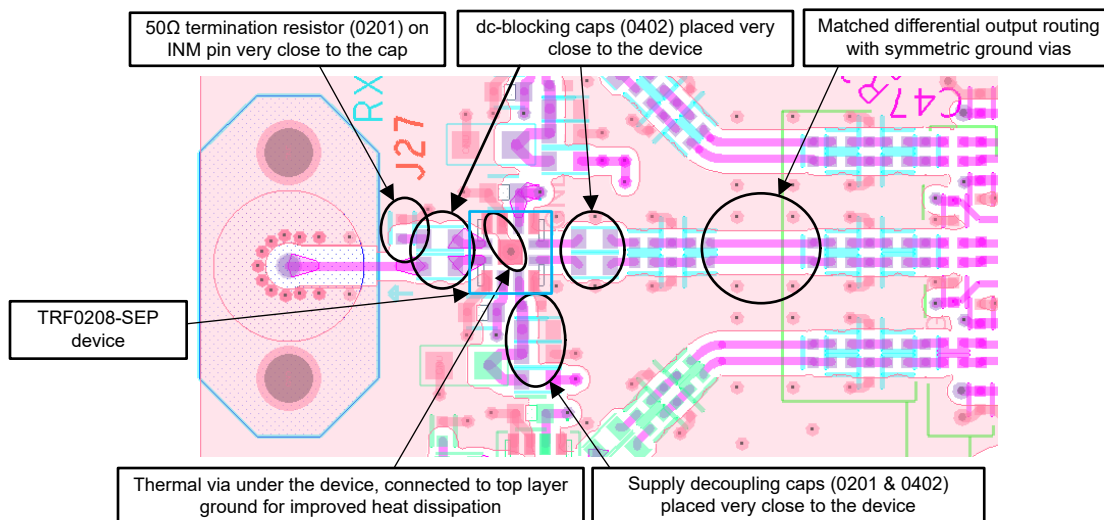


图 7-5. 布局示例 - 布置和顶层布局

TRF0208-SEP 器件可使用 TRF0208-SEP EVM 板进行评估。有关评估板结构和测试设置的更多信息，请参阅 [TRF0208SEP/SP EVM 用户指南](#)。

8 器件和文档支持

8.1 器件支持

8.1.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

8.2 文档支持

8.2.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[TRF0208SEP/SP EVM 用户指南](#)

8.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.4 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

8.5 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

8.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.7 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (March 2023) to Revision A (June 2024)	Page
• 更新了预告信息.....	1

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

10.1 封装选项附录

封装信息

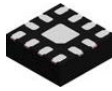
可订购器件	状态 ⁽¹⁾	封装类型	封装图	引脚数	包装数量	环保计划 ⁽²⁾	铅/焊球镀层 ⁽⁶⁾	MSL 峰值温度 ⁽³⁾	工作温度 (°C)	器件标识 ^{(4) (5)}
PTRF0208RPVT/EM	预发布	WQFN-FCRLF	RPV	12	致电 TI	致电 TI	致电 TI	2 级-260C-1 年	致电 TI	致电 TI

- (1) 销售状态值定义如下：
正在供货：建议用于新设计的产品器件。
限期购买：TI 已宣布器件即将停产，但仍在购买期限内。
NRND：不推荐用于新设计。为支持现有客户，器件仍在生产，但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
预发布：器件已宣布，但未进行生产。可能提供样片，也可能无法提供样片。
已停产：TI 已停止生产该器件。
- (2) 环保计划 - 规划的环保分级包括：无铅 (RoHS)，无铅 (RoHS 豁免) 或绿色 (RoHS，无镉/溴) - 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情，请访问 www.ti.com.cn/productcontent。
待定：无铅/绿色环保转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS)：TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求，包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求，因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅 (RoHS 豁免)：该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免：1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点；2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则，元件将根据上述规定视为无铅 (符合 RoHS)。
绿色环保 (RoHS，无镉/溴)：TI 定义的“绿色环保”表示无铅 (符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无镉 (Sb) 系阻燃剂 (均质材料中 Br 或 Sb 的质量不超过总质量的 0.1%)。
- (3) MSL，峰值温度-- 湿敏等级额定值 (符合 JEDEC 工业标准分级) 和峰值焊接温度。
- (4) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标志。
- (5) 如有多个器件标识，将用括号括起来。不过，器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进，说明该行续接上一行，这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
- (6) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽，则会折为两行。

重要信息和免责声明：本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。

在任何情况下，TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。

10.2 机械数据

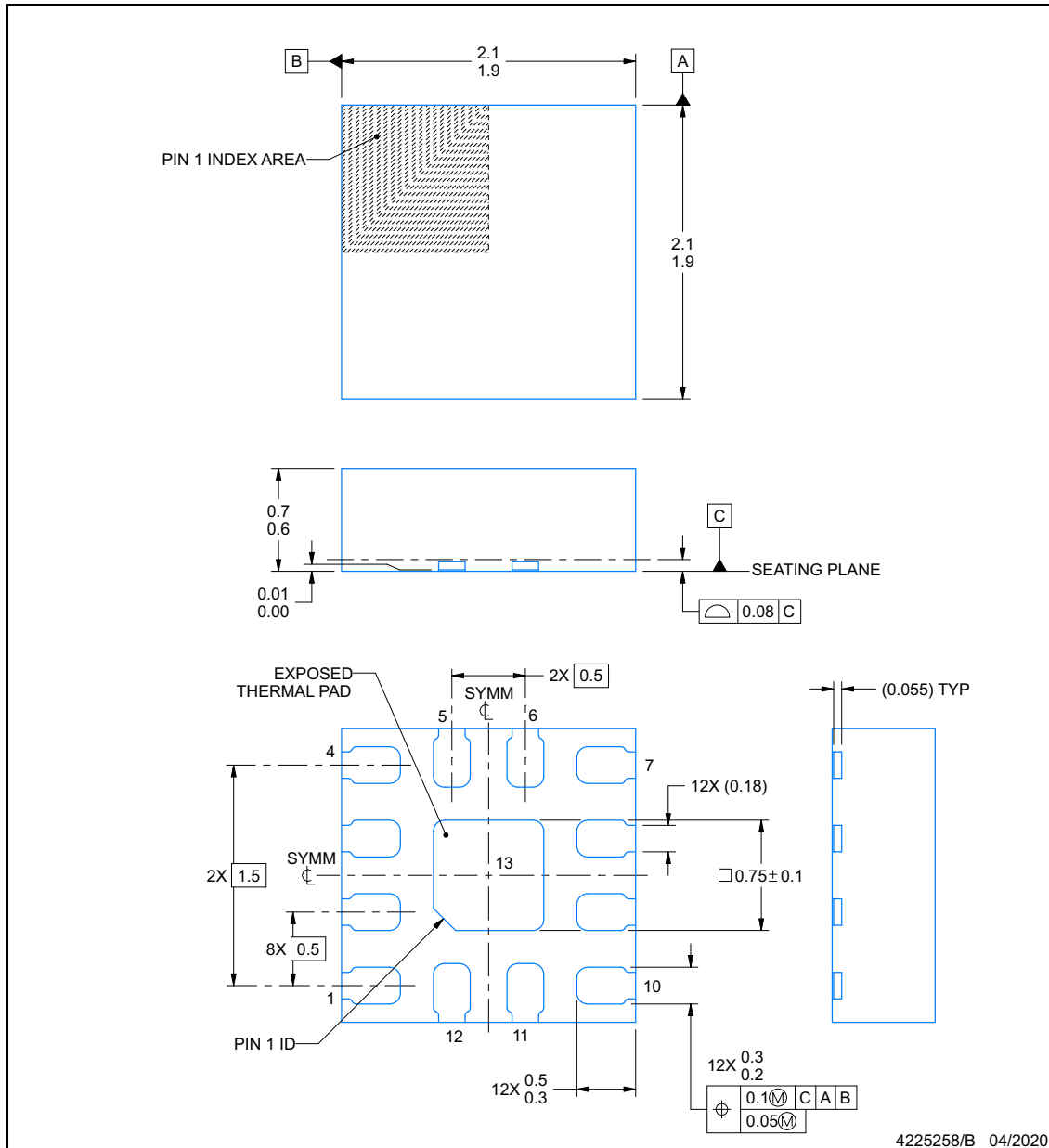


PACKAGE OUTLINE

RPV0012A

WQFN-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

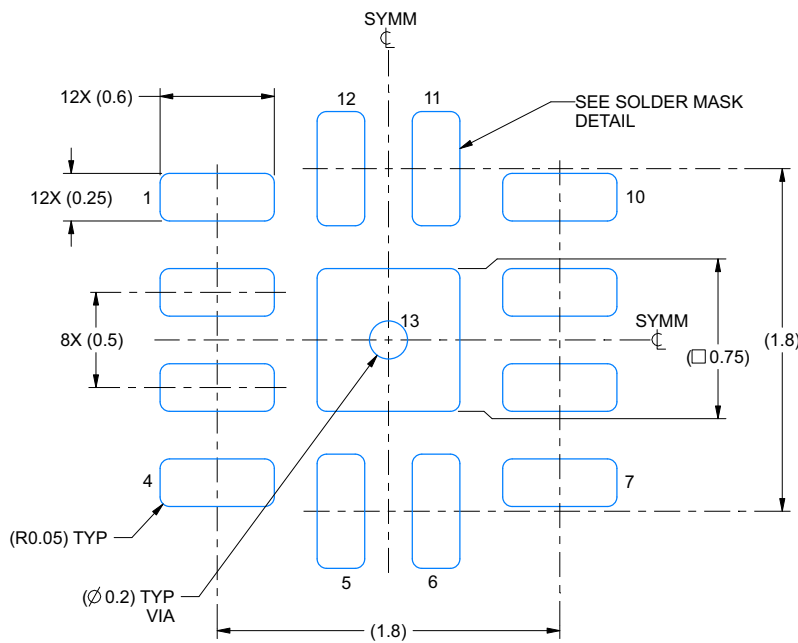


NOTES:

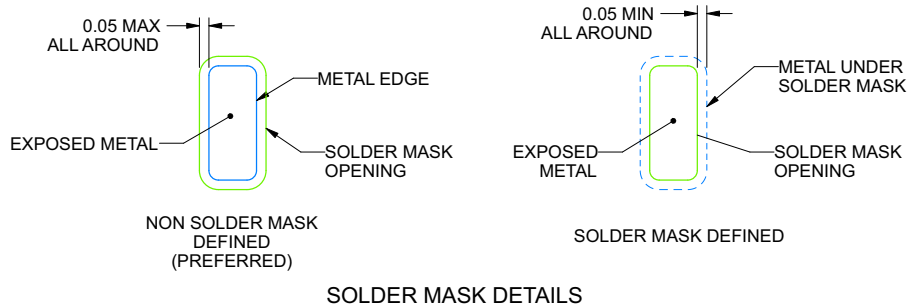
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT**RPV0012A****WQFN-FCRLF - 0.7 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 30X



4225258/B 04/2020

NOTES: (continued)

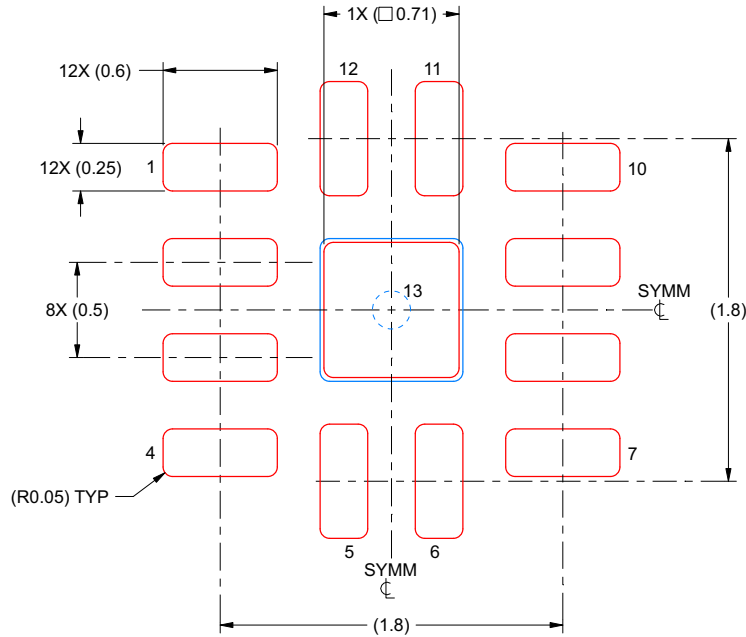
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RPV0012A

WQFN-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 30X
EXPOSED PAD 13
90% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4225258/B 04/2020

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
PTRF0208RPVT/EM	ACTIVE	WQFN-HR	RPV	12	250	TBD	Call TI	Call TI	-55 to 125		Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBsolete: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TRF0208-SEP :

- Space : [TRF0208-SP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Space - Radiation tolerant, ceramic packaging and qualified for use in Space-based application

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司